

武汉理工大学

武汉理工大学 2009 年研究生入学考试试题

课程代码 833 课程名称 材料科学基础

(共 3 页, 共七题, 答题时不必抄题, 标明题目序号即可;

相平衡题目直接做在试卷上, 不必另外画图!!!)

一、 填空题 (30 分)

1. 硅酸盐晶体按化学式中硅氧比的不同, 或按结构中基本结构单元()的不同, 可以对其结构进行分类, 结构方式有()等五种方式, $KAl_2[AlSi_3O_{10}](OH)_2$ 属于()类型。
2. 小角度晶界是相邻两晶粒的位向差()的晶界, 它可分为()和扭转晶界两种基本类型, 前者是由()位错构成, 后者是由螺位错构成。
3. 硅酸盐熔体中各种聚合程度的聚合物浓度受()和()的影响。玻璃体由熔融态向玻璃态转化的过程是(), 在一定温度范围完成, 无固定熔点。
4. 液体的比表面自由能与表面张力()是一致的, 而对于固体来说, 由于固体的表面自由能中包含了(), 表面张力在数值上不等于表面自由能。
5. 相平衡主要研究多相系统的()与()之间的变化规律, 研究凝聚系统相平衡的主要方法有()和()。
6. 扩散是物质内质点运动的基本方式, 扩散的本质是(), 扩散的基本推动力是(), 负扩散是指()。
7. 从热力学观点, 相变可分为()、()等, 前者如熔体结晶等, 后者如()。
8. 固态反应一般包括()和()两个过程。由于固体质点间具有很大的作用键力, 故固态物质的反应活性(), 速度慢。
9. 烧结的推动力是系统的表面能降低, 它可通过扩散传质、()、()、()等四种方式推动物质的迁移。
10. 金属腐蚀可分为()和()两大类; 高分子材料在加工、储存和使用过程中, 由于外界因素的综合作用, 其物理化学性能和机械性能逐渐变坏, 以至最后丧失使用价值, 这称为()。

二、 简要回答下列问题 (20 分)

1. 高分子链结构分为近程结构和远程结构, 它们各自包含哪些内容? (5 分)
2. 纯金属凝固时, 均态核化和非均态核化的形核功大小是否一致? 一般情况下两者哪个大? 为什么? (5 分)
3. 为什么在成核-生长机理相变中, 要有一点过冷或过热才能发生相变? 什么情况下需要过冷,

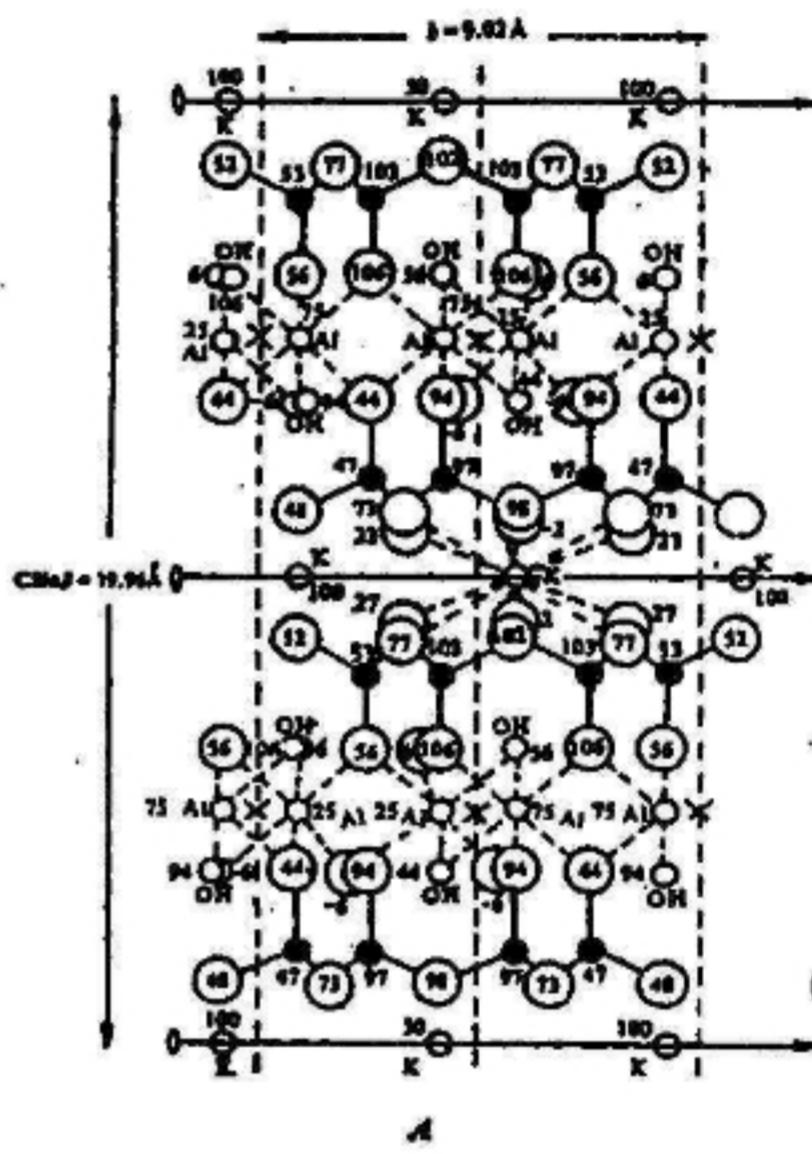
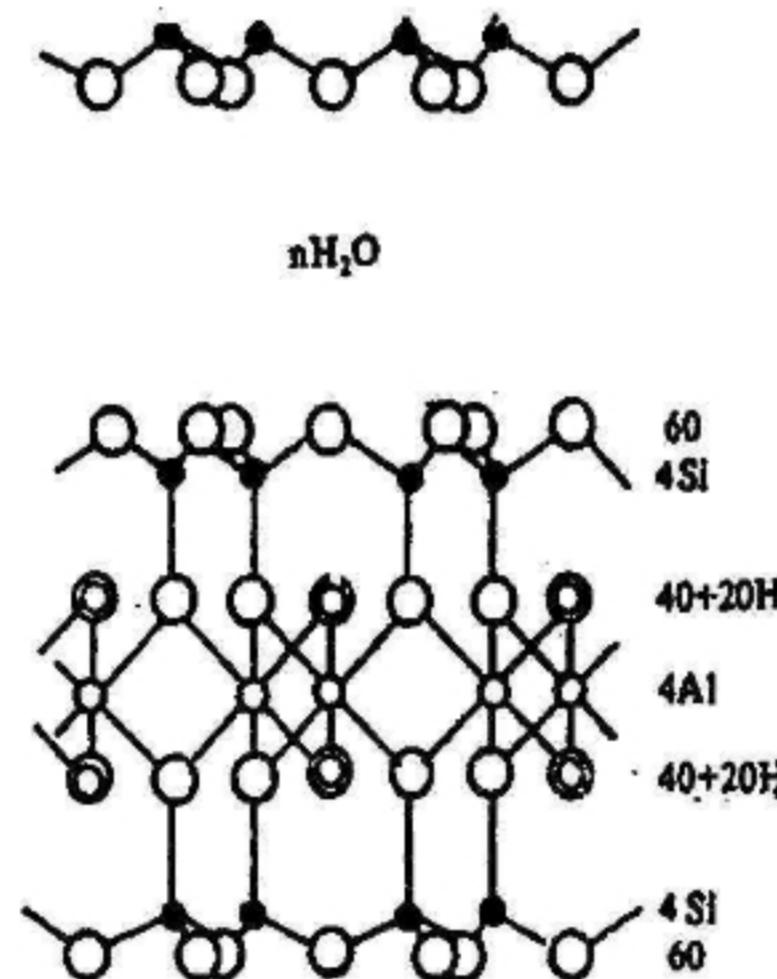
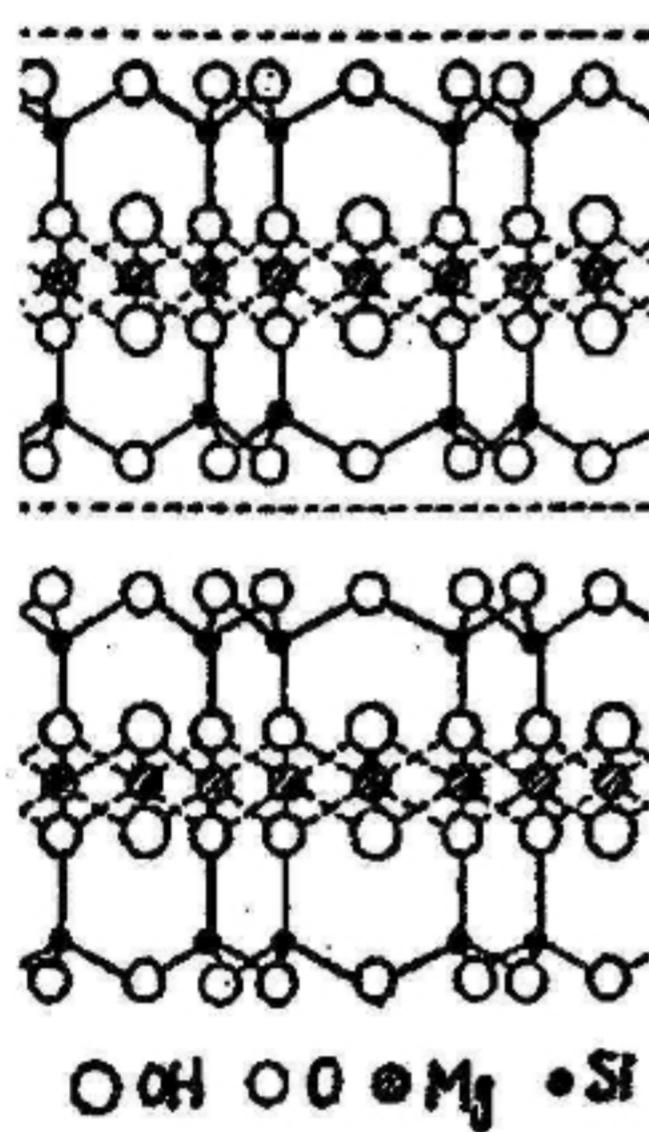
什么情况下需要过热? (5分)

4. 简述杨德方程的优点和局限性。(5分)

三、作图题 (10分)

1. 作图表示立方晶系的晶体中(312)晶面和[132]晶向 (标出坐标系)。(5分)
2. 已知钙钛矿晶体结构属于立方晶系, 其中铁离子位于立方晶胞体心位置、钙离子位于晶胞顶点位置、氧离子位于晶胞面心位置, 请构造钙钛矿结构的晶胞。(5分)

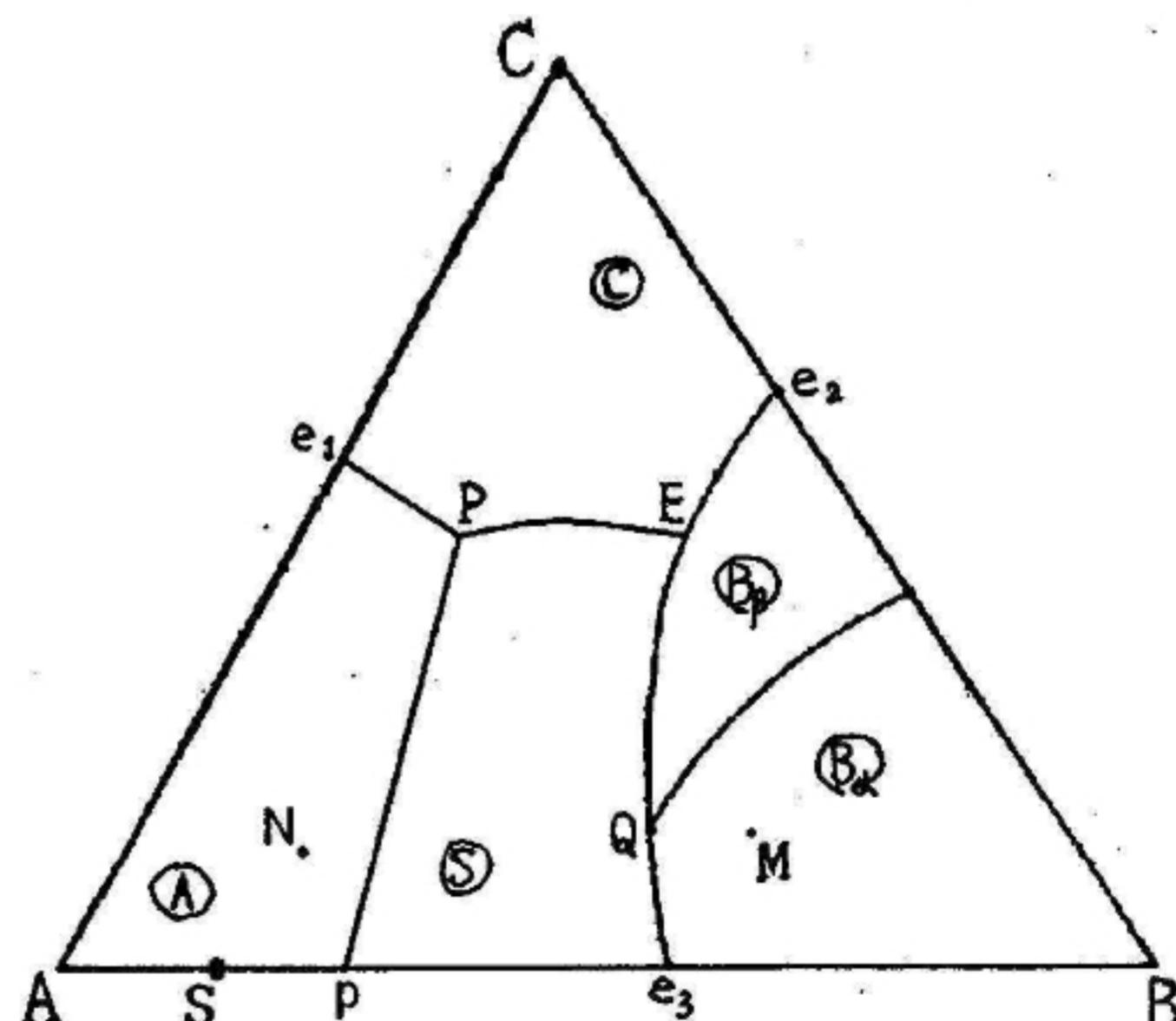
四、参见滑石、蒙脱石、白云母的结构图, 回答下列问题 (20分)



第四题图

1. 说明为什么这些矿物易在垂直 c 轴方向解理? (5分)
2. 为什么滑石粉末有滑腻感而云母粉末没有? (5分)
3. 解释为什么蒙脱石易吸水, 而滑石比较不易吸水? (5分)
4. 用电价规则说明 Al^{3+} 置换骨架中的 Si^{4+} 时, 通常不超过一半, 否则将使结构不稳定。(5分)

五、如图 A-B-C 三元系统相图, 根据相图回答下列问题 (20分)



第五题图

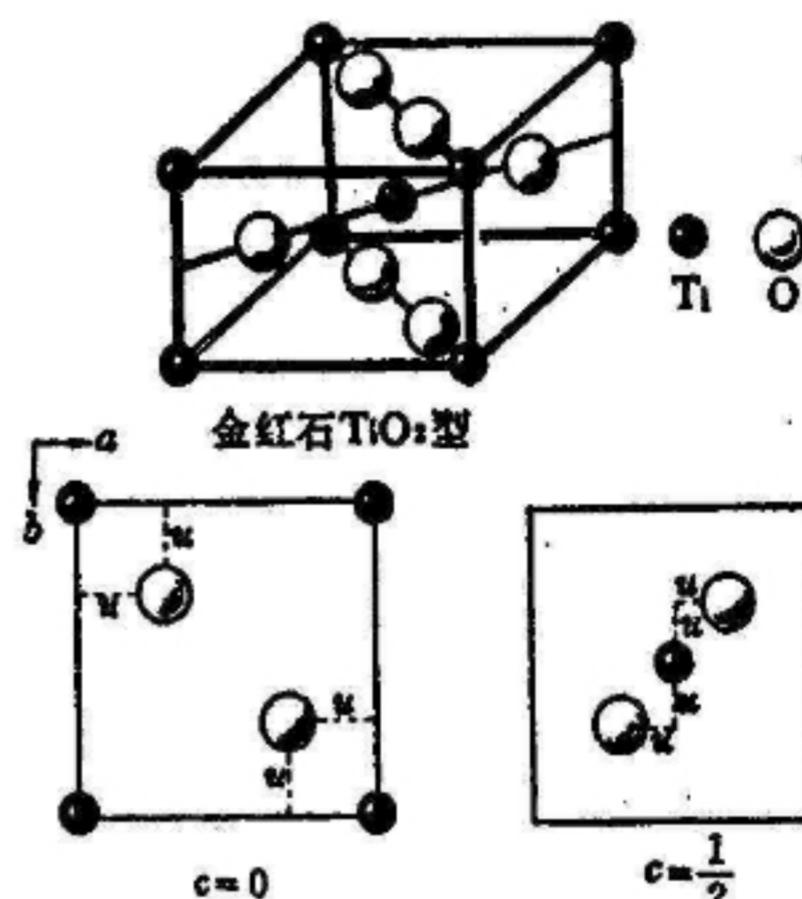
- 在图上划分副三角形、用箭头表示各条界线上温度下降方向及界线的性质；
- 判断化合物 S 的性质；
- 写出各三元无变量点的性质及其对应的平衡关系式；
- 写出组成点 M 在完全平衡条件下的冷却结晶过程，结晶结束时各物质的百分含量（用线段比表示）。

六、根据金红石 (TiO_2) 晶胞图（见下图）回答下列问题（30 分）

- 结构中何种离子作密堆积，何种离子填空隙，空隙利用率是多少？写出正、负离子的配位多面体？（8 分）
- 晶胞分子数是多少？（2 分）
- 在什么样的气氛下烧结，才能获得 TiO_{2-x} ，并写出反应方程式； TiO_{2-x} 是半导体，实际生产中如何控制其电导率，为什么？（10 分）
- 在 Al_2O_3 烧结中，加入少量的 TiO_2 可以明显降低烧结温度，促进烧结，请用缺陷理论分析其原因。（10 分）

七、选做题：下列 4 题任选其中 2 题（20 分）

- 试述玻璃转变与结构调整速率、冷却速率的相互关系。
- 烧结是基于颗粒间的接触和键合，以及物质的传递完成的。那么，颗粒间是怎样键合的？以扩散传质为例，说明烧结的基本推动力是表面张力。
- 金属或合金材料的实际断裂强度往往远低于其理论强度，原因是什么？举例说明金属材料强化的机理。
- Al_2O_3 陶瓷为什么易于发生脆性断裂？举例说明其强化的机理。



第六题图